关键指标

频率：DC～6GHz
插入损耗：1.4dB
隔离度：50dB
电压/电流：+5V/2mA
控制电平：0/+5V
芯片尺寸：1.55mm×1.55mm×0.1mm

产品简介

HG123KF-1 是一款 DC～6GHz 吸收式单刀双掷开关芯片，插入损耗为 1.4dB，隔离度为 50dB。集成控制驱动器，+5V 单电源控制，控制电平 0/+5V。

电性能（T_A=25℃，Vdd=+5V）

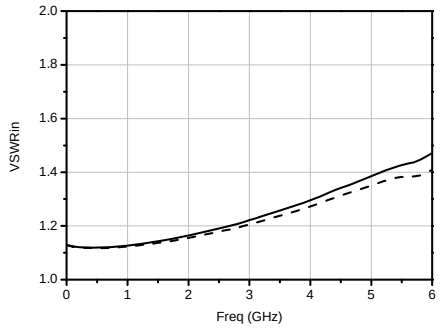
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC～6		
输入驻波	–	1.4	–
输出驻波	–	1.6	–
插入损耗(dB)	–	1.4	–
隔离度(dB)	–	50	–
静态电流（mA）	–	2	–

真值表

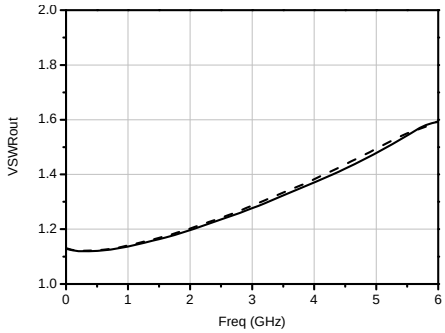
Ctrl	EN	RFC-RF1	RFC-RF2
5V	0V	ON	OFF
0V	0V	OFF	ON
0/5V	5V	OFF	OFF

典型测试曲线

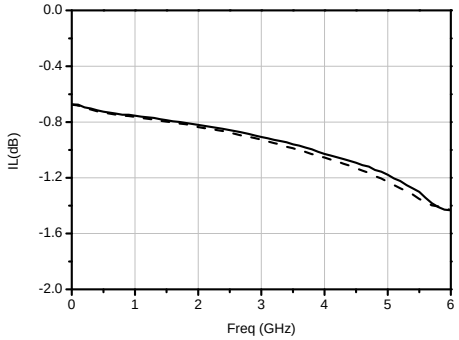
输入驻波



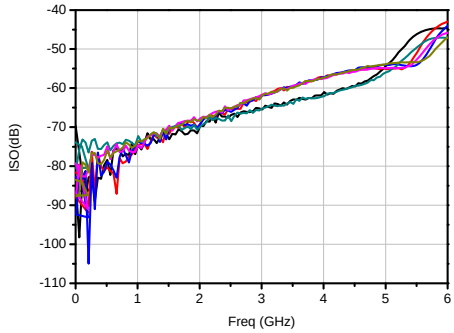
输出驻波



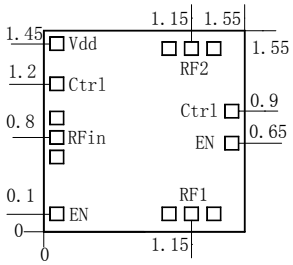
插入损耗



隔离度



外形和端口尺寸（mm）



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
工作电压	+5.5V	
控制电平	低电平：0～0.5V	高电平：3.3～5V
工作温度	-55℃～125℃	
存储温度	-65℃～150℃	

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250～400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。